

isc Silicon NPN Power Transistor

MJE2801T

DESCRIPTION

- Collector-Emitter Breakdown Voltage-
: $V_{(BR)CEO} = 60V(\text{Min})$
- High DC Current Gain-
: $h_{FE} = 25-100@I_C = 3A$
- Complement to Type MJE2901T

APPLICATIONS

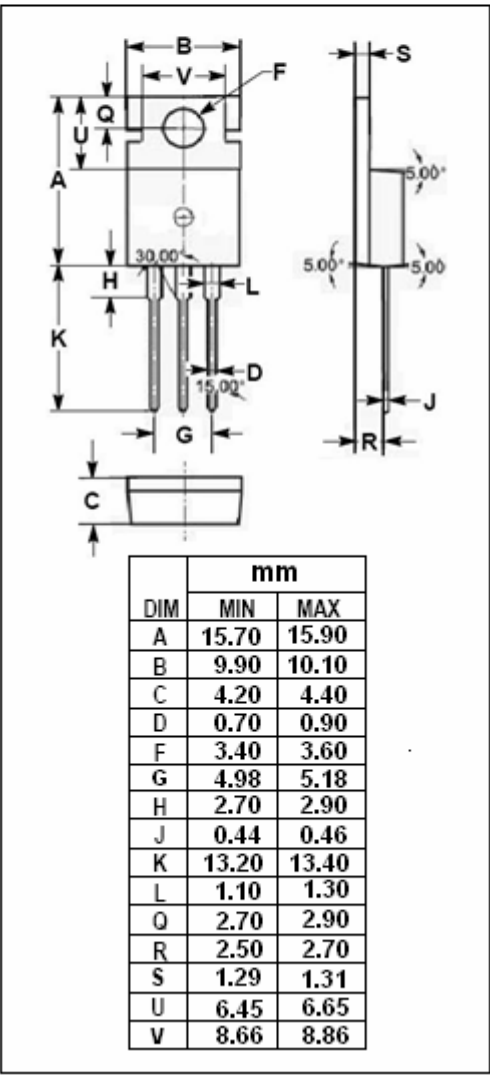
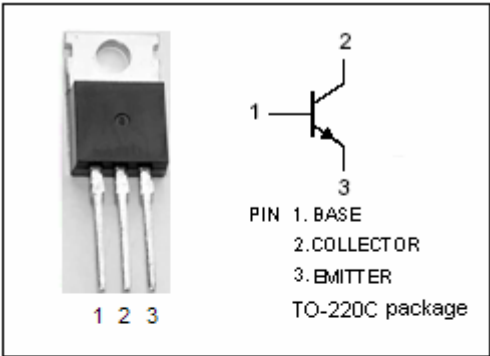
- Designed for use as an output device in complementary audio amplifiers up to 35 watts music power per channel.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS($T_a=25^{\circ}C$)

SYMBOL	PARAMETER	VALUE	UNIT
V_{CBO}	Collector-Base Voltage	60	V
V_{CEO}	Collector-Emitter Voltage	60	V
V_{EBO}	Emitter-Base Voltage	4	V
I_C	Collector Current-Continuous	10	A
I_B	Base Current-Continuous	5	A
P_C	Collector Power Dissipation @ $T_C=25^{\circ}C$	75	W
T_J	Junction Temperature	150	$^{\circ}C$
T_{stg}	Storage Temperature Range	-55~150	$^{\circ}C$

THERMAL CHARACTERISTICS

SYMBOL	PARAMETER	MAX	UNIT
$R_{th\ j-c}$	Thermal Resistance, Junction to Case	1.67	$^{\circ}C/W$



isc Silicon NPN Power Transistor**MJE2801T****ELECTRICAL CHARACTERISTICS** $T_C=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise specified

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP.	MAX	UNIT
$V_{(BR)CEO}$	Collector-Emitter Breakdown Voltage	$I_C=200\text{mA}; I_B=0$	60			V
$V_{CE(sat)}$	Collector-Emitter Saturation Voltage	$I_C=4\text{A}; I_B=0.4\text{A}$			1.1	V
$V_{BE(on)}$	Base-Emitter On Voltage	$I_C=3\text{A}; V_{CE}=2\text{V}$			1.4	V
I_{CBO}	Collector Cutoff Current	$V_{CB}=60\text{V}; I_E=0$ $V_{CB}=60\text{V}; I_E=0; T_C=150^{\circ}\text{C}$			0.1 2.0	mA
I_{EBO}	Emitter Cutoff Current	$V_{EB}=4\text{V}; I_C=0$			1.0	mA
h_{FE}	DC Current Gain	$I_C=3\text{A}; V_{CE}=2\text{V}$	25		100	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9